

حافظه ی نازک بر اساس تک- لایه ی بُر- نیتريد

حافظه ی مقاومتی بر این اساس است که ماده دُ حالتِ مقاومت- کم و مقاومت- زیاد دارد. با تک- لایه ی بُر- نیتريد شش- ضلعی حافظه- ی- مقاومتی بی ساخته اند که نازک- ترین از این گونه تا کنون است. کلفتی ی این حافظه 0.33 nm، و نسبتِ مقاومتها ی دُ- حالتِ آن 10^7 است [1].

[1] Advanced Materials doi 10.1002/adma.201806790